

製品概要

FDMQ8205A: GreenBridge™ 2 シリーズ高効率ブリッジ整流器

技術情報は、データシートをご参照ください。

FDMQ8205Aは、ブリッジアプリケーション向けのGreenBridge™2シリーズクワッドMOSFETであるため、入力デバイスに接続された電源の極性に影響されません。既知のブリッジ整流回路の多くは、一般的なダイオードを使用して構成することができます。従来のダイオードブリッジの電力損失は比較的高く、多くのアプリケーションでは望ましくありません。特に、Power over Ethernet (PoE) Power Device (PD) アプリケーションには、IEEE802.3atで分類されたPower Source Equipment (PSE) から供給される限られた電力で作動する必要があるため、高効率のブリッジが必要です。FDMQ8205Aは、低 $r_{DS(on)}$ デュアルPチャネル MOSFETおよびNチャネル MOSFETで構成されているため、従来のダイオードブリッジと比較して、電圧降下による電力損失を低減できます。FDMQ8205Aにより、アプリケーションは利用可能な電力と電圧を最大化し、PoE PDアプリケーションでの熱設計の問題を排除することができます。FDMQ8205A GreenBridge™2は、検出と分類機能を損なうこともなく、IEEE802.3at PoE規格と互換性があります。

特長

- 低電力損失のGreenBridge™でダイオードブリッジを置換
- MOSFET用自己駆動回路
- 低 $r_{DS(on)}$ 100V定格MOSFET
- 利用可能な電力と電圧を最大化
- 温度設計の問題を排除
- IEEE802.3at対応 - 検出と区分の要件を満たす - 2および4ペアアーキテクチャで動作 - 小さいバックフィード電圧
- 小型MLP 4.5x5パッケージ

アプリケーション

- This product is general usage and suitable for many different applications.

最終製品

- IP Phones
- Network Cameras
- Wireless Access Points
- Thin Clients
- Microcell

電氣的仕様

製品	Pricing (\$/Unit)	Compliance	Status	Channel Polarity	Configuration	$V_{DS(sat)}$ Min (V)	V_{GS} Max (V)	$V_{GS(th)}$ Max (V)	I_D Max (A)	P_D Max (W)	$R_{DS(on)}$ Max @ $V_{GS} = 2.5V$ (mΩ)	$R_{DS(on)}$ Max @ $V_{GS} = 4.5V$ (mΩ)	$R_{DS(on)}$ Max @ $V_{GS} = 10V$ (mΩ)	Q_g Typ @ $V_{GS} = 4.5V$ (nC)	Q_g Typ @ $V_{GS} = 10V$ (nC)	C_{iss} Typ (pF)	Package Type
FDMQ8205A	1.1544	Pb-free Halide free non AEC-Q and PPAP	Active	Complementary	Quad	-	-	-	-	2.5	-	-	-	-	-	-	WDFN-12

詳細は、弊社 www.onsemi.jp の営業または販売代理店にお問い合わせください。

1/20/2021 作成